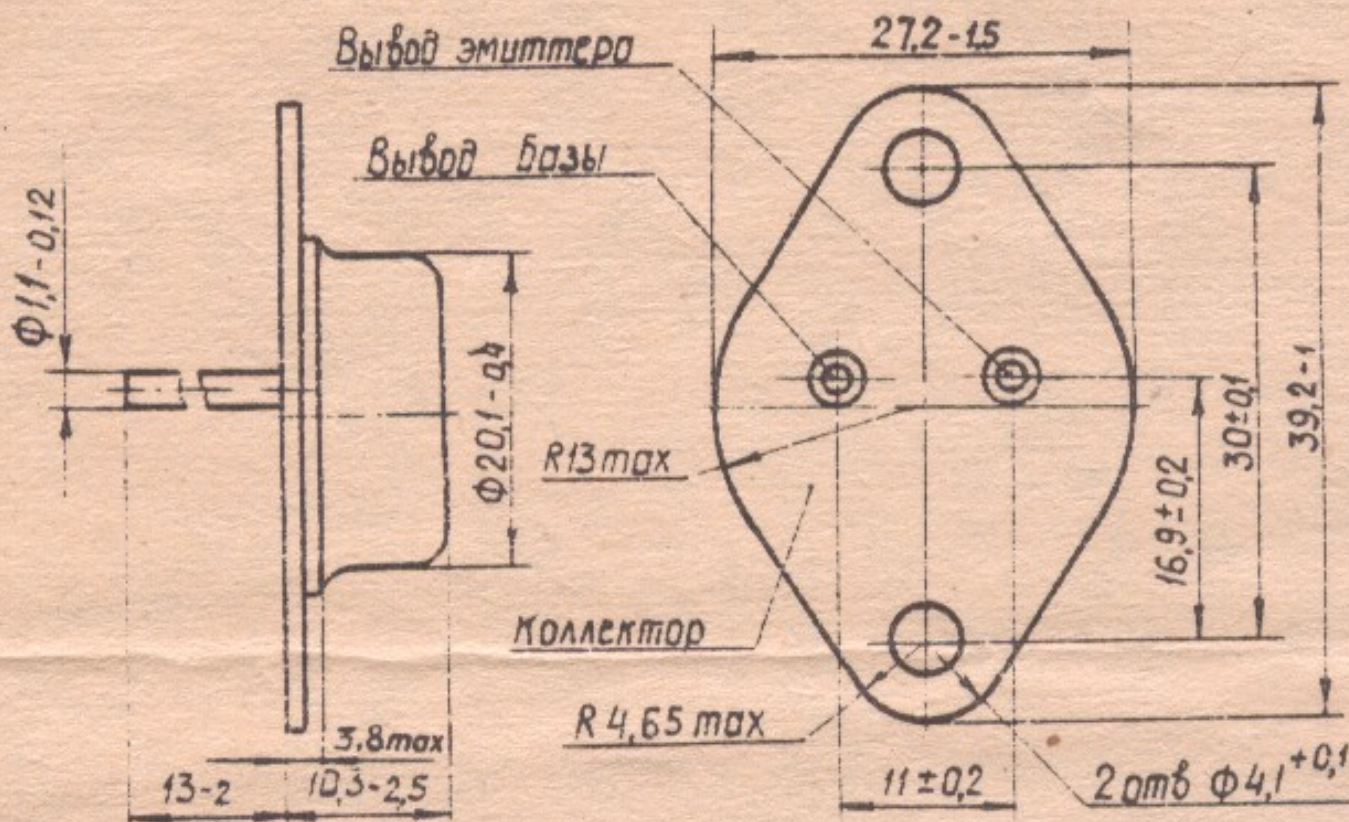


# Этикетка

Транзисторы типов:  
2Т825А, 2Т825Б, 2Т825В  
соответствуют  
требованиям  
технических условий  
ОАО. 339.054 ТУ



Масса транзистора не более 20г.

Содержание драгоценных металлов в

1000 шт транзисторов

Золото 9932,5 (мг)

Серебро 45787,4 (мг)

Основные электрические параметры при  
 $t_{окр.} = 25^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ .

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
1. Пробивное напряжение коллектор-эмиттер ( $I_k = 0,001\text{A}$ , $U_{бэ} = 1,5\text{В}$ ), 2Т825А 2Т825Б 2Т825В В	$U_{кэх\ проб}$	100 80 60	
2. Граничное напряжение ( $I_э = 0,1\text{A}$ , $Q \geq 100$ , $t_{ш} \leq 300\text{мкс}$ ) 2Т825А 2Т825Б 2Т825В В	$U_{кэогр}$	80 60 45	
3. Пробивное напряжение эмиттер-база ( $I_э = 0,002\text{A}$ ), 2Т825А + 2Т825В В	$U_{эбэ\ проб}$	5	
4. Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ( $I_k = 10\text{A}$ , $I_б = 0,04\text{A}$ ), 2Т825А + 2Т825В В	$U_{кэнас}$		2
5. Напряжение насыщения база-эмиттер ( $I_k = 10\text{A}$ , $I_б = 0,04\text{A}$ ), 2Т825А + 2Т825В В	$U_{бэнас}$		3
6. Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером ( $I_э = 10\text{A}$ , $U_{кб} = 10\text{В}$ ) 2Т825А 2Т825Б 2Т825В	$h_{21э}$	500 750 750	18000 18000 18000

Штамп ОТК

Штамп представителя  
заказчика

